

# КТ601А, КТ601АМ

## Электрические параметры

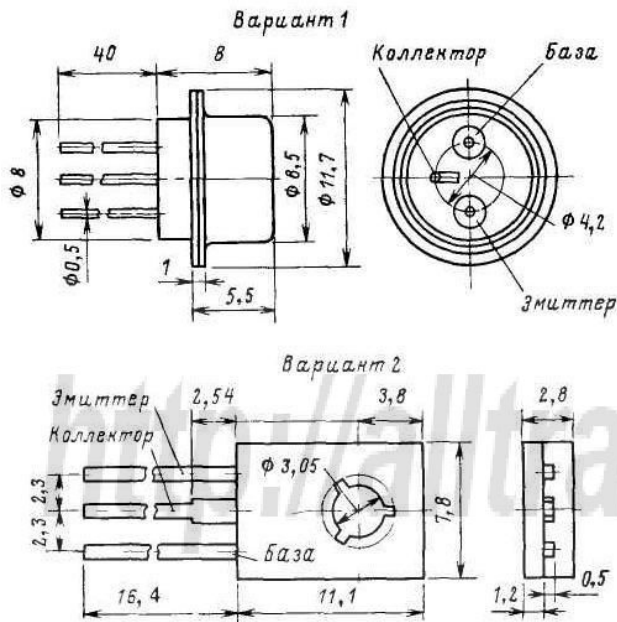
Транзисторы кремниевые диффузионные *n-p-n* усилительные высокочастотные маломощные

Предназначены для применения в схемах радиовещательных и телевизионных приемников

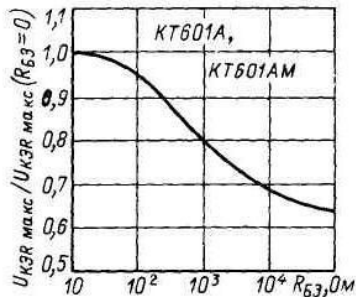
Выпускаются в металлостеклянном (КТ601А) и в пластмассовом (КТ601АМ) корпусах с гибкими выводами

Обозначение типа приводится на корпусе

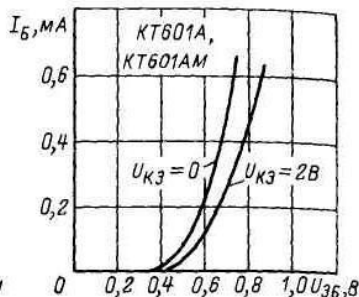
Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 2 г, в пластмассовом не более 0,7 г



Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. Пайку следует производить в течение не более 5 с. Температура пайки не должна превышать 533 К, при этом необходимо обеспечить надежный теплоотвод между корпусом транзистора и местом пайки.



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер



Входные характеристики

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при  $U_{КЭ} = 20$  В,  $I_{Э} = 10$  мА не менее . . . . . 16

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КЭ} = 20$  В,  $I_{Э} = 1$  мА не менее . . . . . 40 МГц

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ} = 20$  В,  $f = 2$  МГц не более . . . . . 15 пФ

Постоянная времени цепи обратной связи при  $U_{КЭ} = 50$  В,  $I_{Э} = 6$  мА,  $f = 2$  МГц не более . . . . . 600 пс

Обратный ток коллектор-эмиттер при  $U_{КЭ} = 100$  В,  $R_{БЭ} = 10$  кОм не более . . . . . 500 мкА

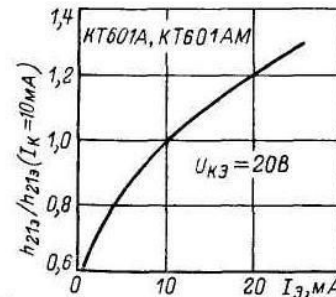
Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭБ} = 2$  не более . . . . . 100 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

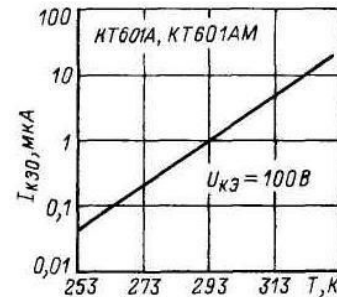
Постоянное напряжение коллектор-база . . . . .	100 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10$ кОм . . . . .	100 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .	2 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	30 мА
Постоянный ток базы . . . . .	30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность без теплоотвода при $T \leq 328$ К и $T_{к} \leq 348$ К . . . . .	250 мВт
с теплоотводом при $T_{к} \leq 328$ К . . . . .	500 мВт
Температура перехода . . . . .	423 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до 358 К

Примечание Для транзисторов в металлостеклянном корпусе изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба не менее 3 мм, при этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность выводов между местом изгиба и стеклянным изолятором.

Для транзисторов в пластмассовом корпусе изгиб выводов допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и на расстоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.



Зависимость относительного коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость обратного тока коллектор-эмиттер от температуры